

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Основы электроники Лабораторный практикум №7

Студент: Факирзаи Амджад

Группа : ИУ7 - 36Б

Вариант: 19

Цель работы:

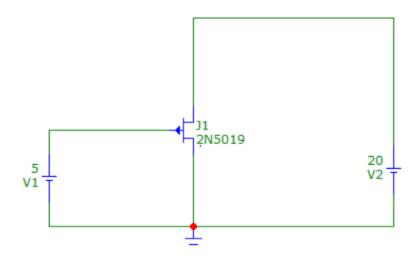
Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных, ключевых и логических устройств на биполярных и полевых транзисторах

Параметры транзисторов

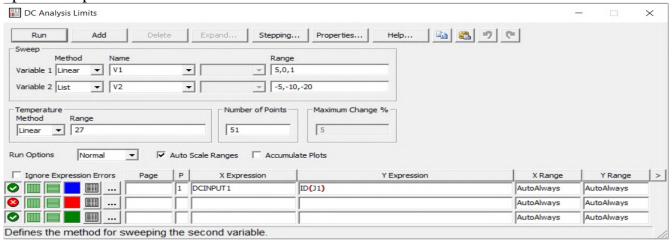
В работе применяется вариант транзисторов N 19 — модель PJFET 2N5019, а также модель NMOS IRF533 и модель PMOS IRF9533 из стандартной библиотеки Microcap.

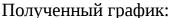
ЭКСПЕРИМЕНТ 7

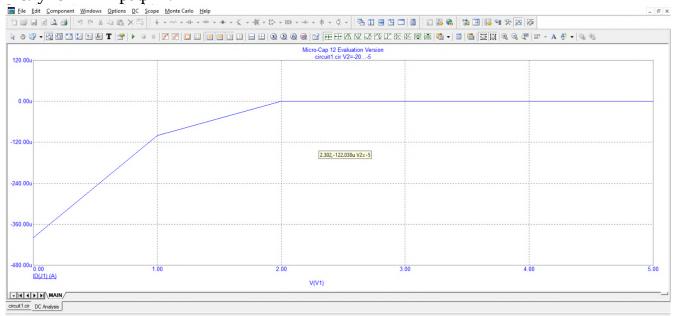
Характеристики полевого транзистора. Строим схему с транзистором РЈFET:

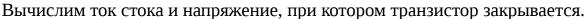


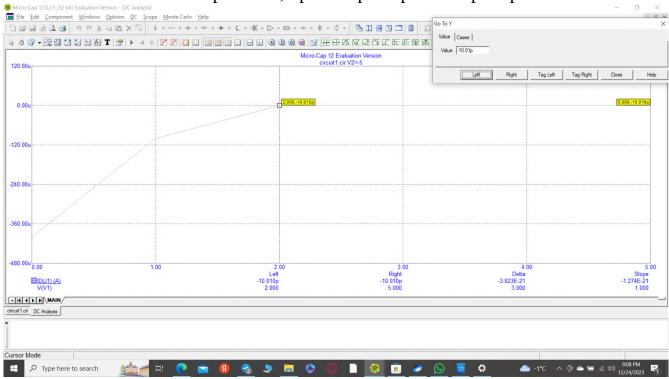
Настроим анализ постоянного тока (DC) для получения переходных характеристик транзистора.

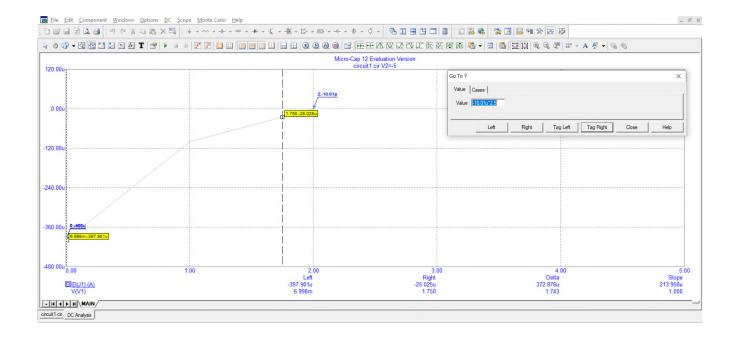






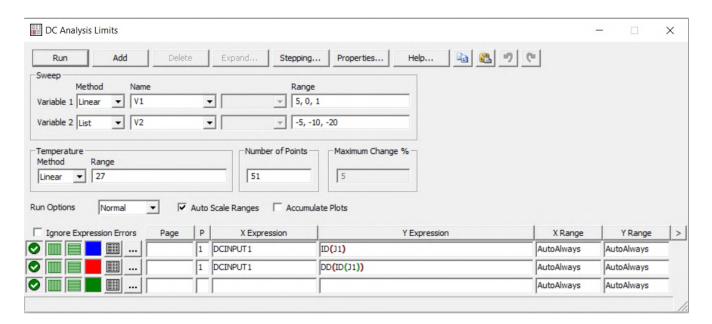


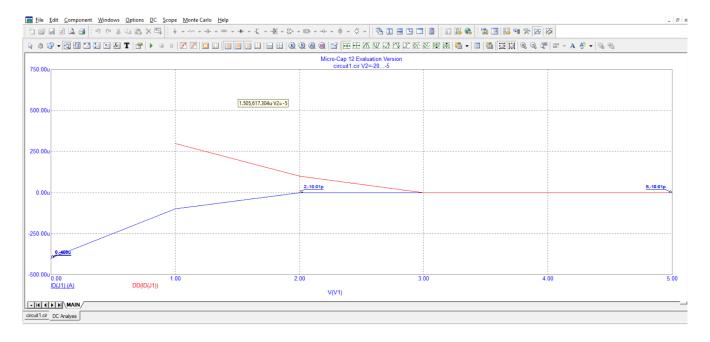


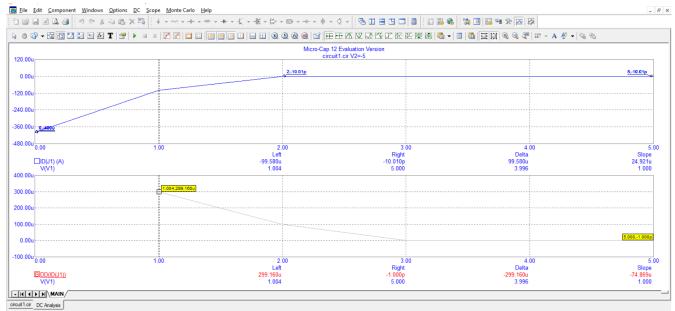


Напряжение, при котором транзистор закрывается, приблизительно составляет 1.750В. Начальный ток стока около 10.01 мА. Напряжение отсечки 2В.

Создаем дополнительный график производной тока стока от напряжения на затворе с целью выявления максимальной крутизны характеристики.





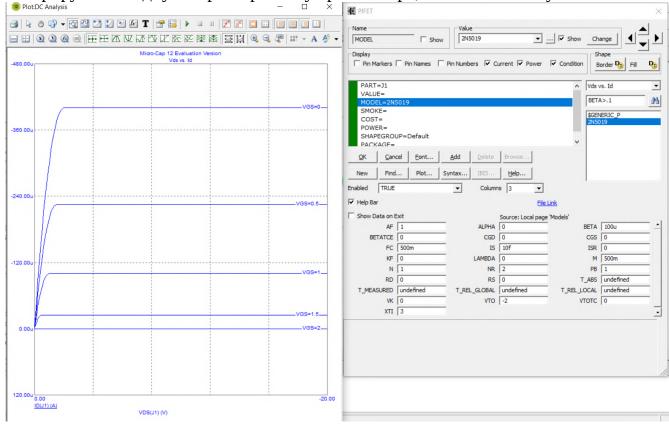


На графике определена максимальная крутизна характеристики, которая составляет 299,160 мА/В.

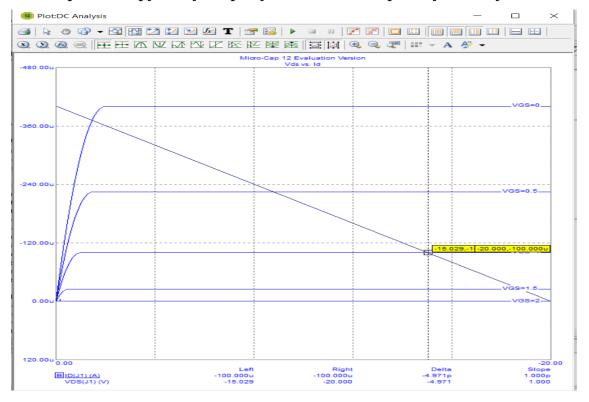
Максимальная крутизна по формуле:

Smax = 2*Iсисx/|Uотсечки| = 2*10.01 мA/2 В $\sim = 10,01$ мА/В.

Генерируем выходную характеристику транзистора, нажимая кнопку "Plot".

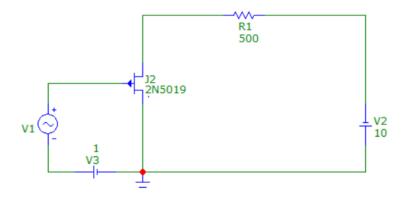


Построим нагрузочную прямую и вычислим рабочую точку.

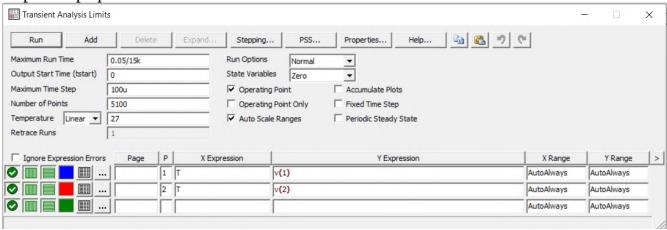


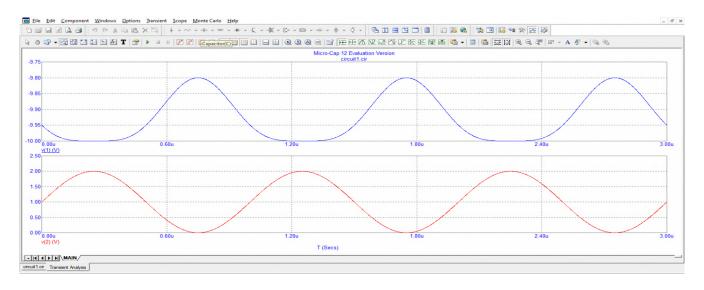
По графику Епит = 20 B, Upт = 15 B, Id = 100 м А Rd = (Епит – Upт)/Id. Rd = 500 Ом

Строим схему усилитель:



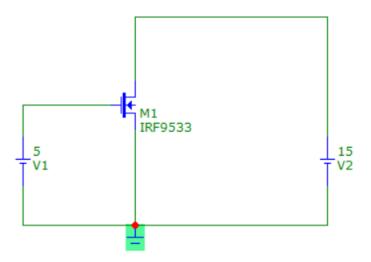
Строим график Transient:



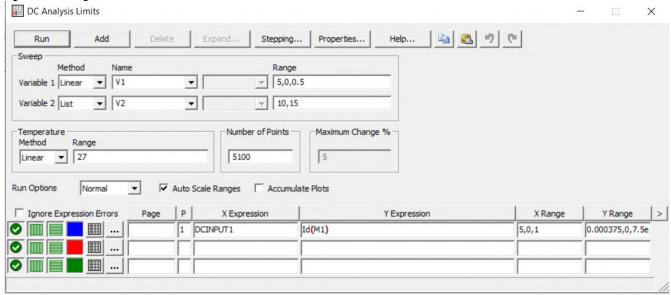


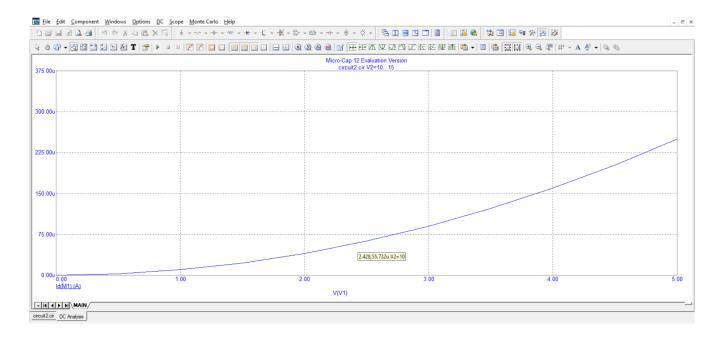
Коэффициент усиления приблизительно равен 2 / 0.2 = 10

Аналогично получаем характеристики NMOS. Переходные характеристики NMOS:

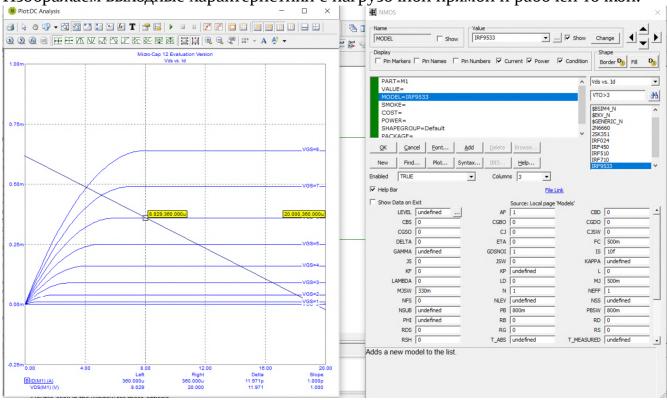


Настроим анализ постоянного тока (DC) для получения переходных характеристик транзистора.



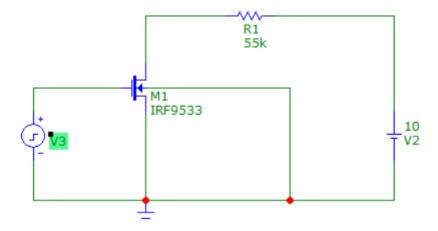


Изображаем выходные характеристики с нагрузочной прямой и рабочей точкой.

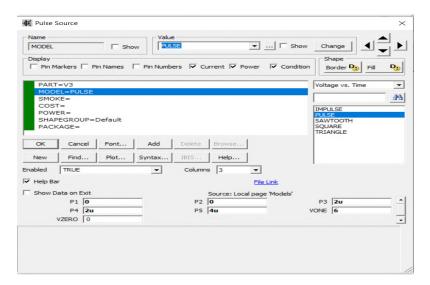


Сопротивление стока: Rd = Eпит / Id = 20 B / 360 MkA = 55 kOm. Vone = Vgs = 6 B.

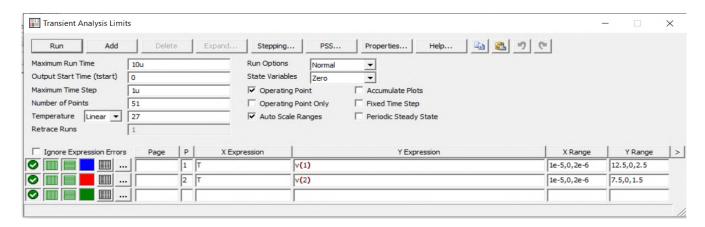
Строим схему ключа на транзисторе:

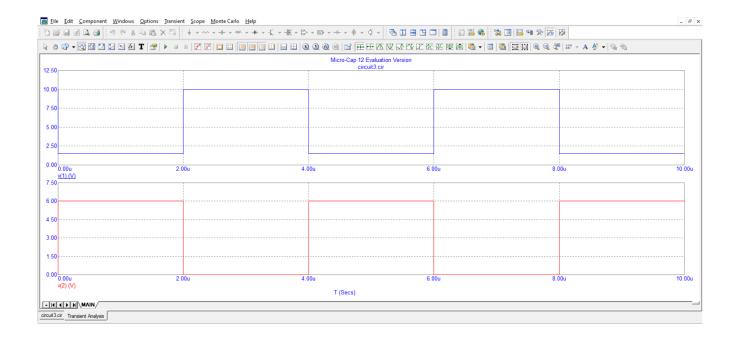


Параметры генератора



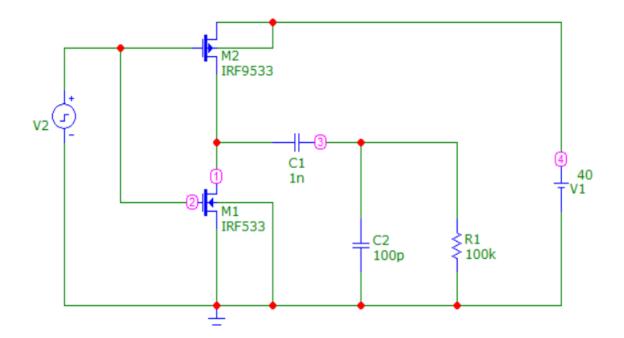
Строим график с помощью Transient:



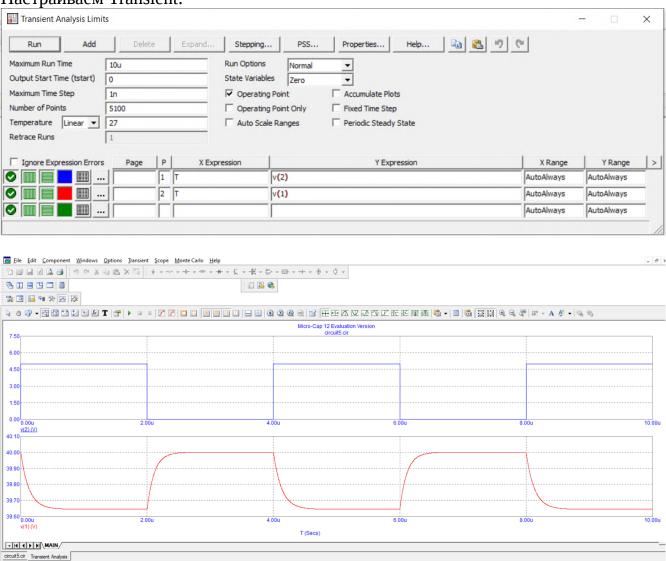


ЭКСПЕРИМЕНТ 8.

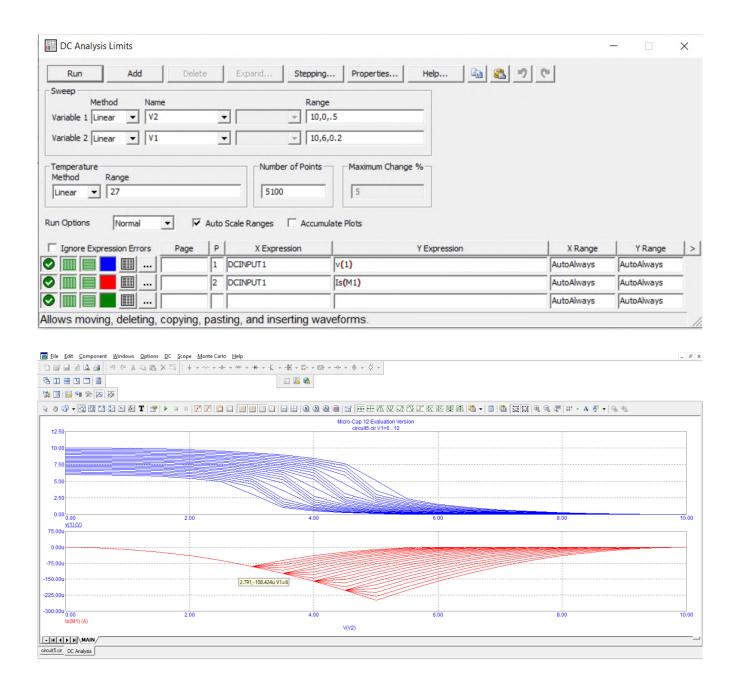
Комплементарные схемы. Инвертор на основе КМОП ключа.



Настраиваем Transient:

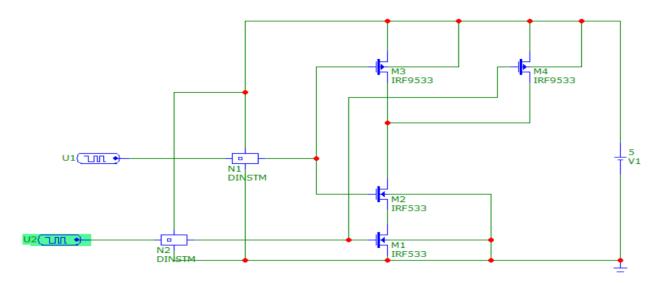


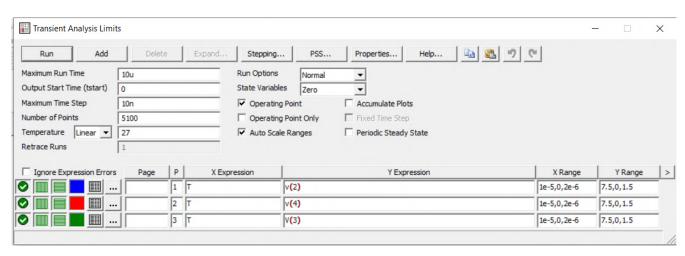
Настроим анализ постоянного тока (DC) для получения переходных характеристик транзистора.

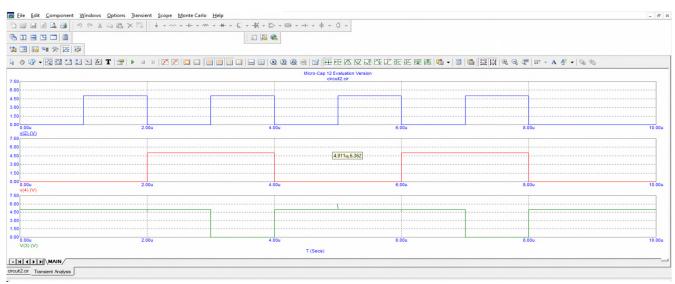


Получим передаточные характеристики с помощью анализа по постоянному току. Исходя из полученных характеристик, определим напряжения, при которых открываются транзисторы -3~B и 5.03~B, а также максимальный ток -0.24~mA. Здесь, как и ранее, в качестве "нулевого" уровня тока выбрано значение тока в 1/1000~от максимального.

Разрабатываем логический элемент 2И-НЕ:

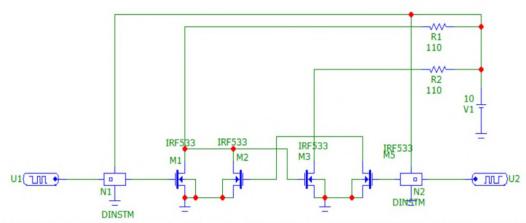




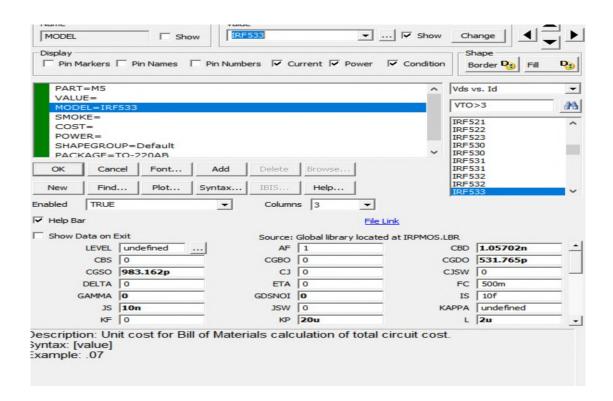


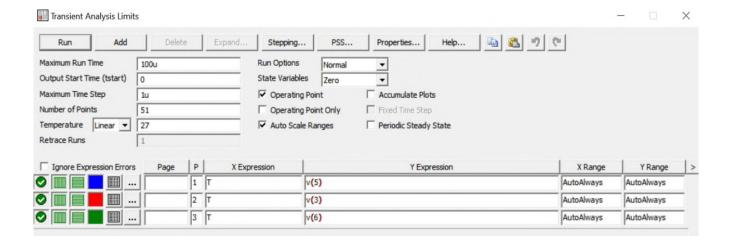
ЭКСПЕРИМЕНТ 9

Разрабатываем структуру ячейки триггера статической памяти.



0 0 label=start 10us 0 20us 0 40us 1 42us 0 70us 1 72us 0 90us 1 92us 0 0 label=start 10us 1 12us 0 30us 0 40us 0 50us 1 52us 0 80us 1 82us 0





Полученный график:

